

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-023390

(43)Date of publication of application : 23.01.2002

(51)Int.Cl.

G03F 7/40
H01L 21/027
H01L 21/3065

(21)Application number : 2001-074870

(71)Applicant : HYNIX SEMICONDUCTOR INC

(22)Date of filing : 15.03.2001

(72)Inventor : KIM GI-HYEON
PARK SANG-SOO

(30)Priority

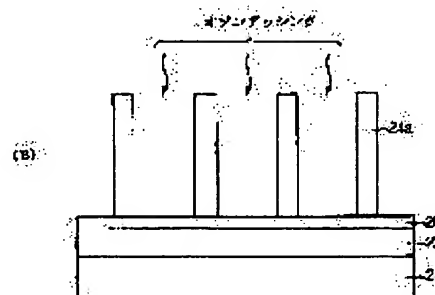
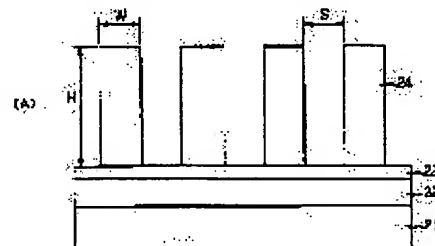
Priority number : 2000 200035969 Priority date : 28.06.2000 Priority country : KR

(54) METHOD FOR FORMING PHOTSENSITIVE FILM PATTERN OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for forming a photosensitive film pattern of a semiconductor device by which the deformation and dimensional change of a fine photosensitive film pattern can be prevented.

SOLUTION: A photosensitive film pattern 24 is formed on a semiconductor substrate 21 on which a prescribed electrically conductive layer 22 has been formed and the line width of the pattern 24 is reduced using oxygen radicals generated by the thermal decomposition reaction of gaseous ozone.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's]

02ED0235

JP JPDS

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許公開番号
特開2002-23390
(P2002-23390A)
(43) 公開日 平成14年1月23日 (2002.1.23)

(51) Int.Cl.	識別記号	FI	チート(参考)
G03F 7/40	511	G03F 7/40	511 2H096
H01L 21/027		H01L 21/30	572A 5F004
21/3065		21/302	H 5F046

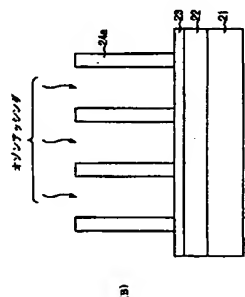
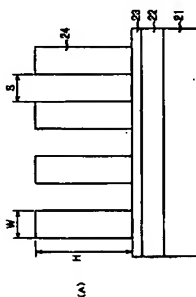
審査請求 未請求 請求項の数 9 OL (全 6 頁)

(21) 出願番号	特開2001-74870(P2001-74870)	(71) 出願人	591024111
(22) 出願日	平成13年3月15日 (2001.3.15)	株式会社ハイニックスセミコンダクター	
(31) 優先権主張番号	35969/2000	大韓民国京畿道利川市大韓色牙英里山136	
(32) 優先日	平成12年6月28日 (2000.6.28)	金 起 賢	
(33) 優先権主張国	国 (KR)	大韓民国京畿道利川市大韓色牙英里山136	
		朴 相 洙	
		大韓民国京畿道利川市大韓色牙英里山136	
		尹聖士 崔島 富二雄 (外1名)	
		100078330	

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体素子の感光膜パターンの形成方法

(57) 【要約】
【課題】 微細な感光膜パターンの崩れや大きさの変動を防止し得る半導体素子の感光膜パターンの形成方法を提供すること。
【解決手段】 所定の電導層22が形成された半導体基板21上に感光膜パターン24を形成し、オゾンガスの熱分解反応により発生される酸素ラジカル成分を用いて上記感光膜パターン24の線幅を微細化させる。



【0011】

【発明が解決しようとする課題】上述したような従来の半導体素子の感光膜パターンの形成方法において、感光膜パターン14の幅Wに対する高さHの比率H/Wの値が4とならない場合には、図4(B)に示したように、微細化された感光膜パターン14aは崩れることとなる。

【0012】また、図5に示したように、現像工程における露光処理後、感光膜パターン14が崩れることにより、後続するプラズマエッチング装置によるエッチング処理時には、微細化された感光膜パターン14aの深さが減り、大きさの変動が発生する。

【0013】本発明は、上記従来の技術の問題点を解決するための案出されたものであって、微細な感光膜パターンの崩れや大きさの変動を防止して、通常の露光装置の限界解像力以上の微細な線幅の感光膜パターンを形成し得る半導体素子の感光膜パターン形成方法を提供することを目的とする。

【0014】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するため、本発明にかかる半導体素子の感光膜パターンの形成方法は、露光装置により半導体基板上に形成された感光膜パターンを露光ラジカル成分でアッシングする工程を含むものである。そして、上記露光ラジカル成分は、オゾンアンシャーマ装置を介して供給されるオゾンを熱分解して生成したり、紫外線照射により生成したりするものである。また、上記感光膜パターンは、上記半導体基板を保持するヒーターブロックにより加熱することである。また、上記アッシング工程は、大気圧下で行うこととする。そして、上記オゾンアンシャーマ装置から供給するオゾンは、酸素は5～7vol%の濃度とする。

また、上記感光膜パターンと露光ラジカル成分との反応は、約130～200℃で行うこととする。なお、上記感光膜には、ポジタイプ型感光膜及びネガティブ型感光膜のいずれかを用いる。また、上記露光装置における光源には、KrF-エキシマレーザ、ArF-エキシマレーザ、g線及びi線のいずれか1つを用いることとする。

【0015】

【発明の実施の形態】以下、本発明の最も好ましい実施形態を添付図面を参照して、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に詳細に説明する。

【0016】

【0017】図1は、本発明の実施形態にかかる半導体素子の感光膜パターンの形成方法の各工程を示す断面図である。

【0018】図1(A)に示したように、半導体基板21上に電導層22として、例えば、ポリシリコン又はメタルを蒸着した後、感光膜パターンニング工程を円周にす

るために、上記電導層22上に反射防止膜23を形成し、KrF-エキシマレーザを用いたステッパー方式で露光して、感光膜パターン24を形成する。上記形成した感光膜パターン24は、一定の間隔Sを置いて、一定の高さHと一定の幅Wに形成される。この場合、上記感光膜パターン24の幅Wは、170nmまで形成可能である。

【0019】次に、図1(B)に示したように、オゾンアンシャーマ装置（図示省略）から供給されるオゾン(O₃)から露光ラジカル成分(O*)を生成し、この露光ラジカル成分を用いて、上記感光膜パターン24を大気圧下、かつ、低温で、時間に応じて、均一でパターン崩れ無しにスリム化させて、微細化された感光膜パターン24aを形成する。

【0020】上記感光膜パターン24と露光ラジカル成分との反応温度は、約130～200℃の低温とする。アッシング率の調節は可能であり、温度が低いほどアッシング率が低くなり、感光膜パターン24aを微細に形成し得る。また、露光ラジカル成分を用いたアッシングでは、イオンによる衝撃及び荷電された粒子によるアッシング損失が発生しないので、少数キャリアの寿命に影響を及ぼさず、かつ、大気圧下で行うので、真空装置が不要である。

【0021】さらに、露光ラジカル成分を用いたアッシングにより、マイクログローディング効果は、低圧及びここで、上記マイクログローディング効果とは、低圧及び微細領域（マイクロスペース）でイオン自体を分散させることで、感光膜パターン24に対して垂直に移動するイオンによってエッチング率が減少する現象をいう。露光ラジカル成分を用いたアッシングを実施することで、マイクログローディング効果による感光膜パターン24のエッチング率の減少を防止し得る。

【0022】図2は、オゾンアンシャーマ装置を用いて、図1(A)に示した感光膜パターン24を微細化する方法を説明するための図である。

【0023】上記オゾンアンシャーマ装置は公知のエッチング装置である。このオゾンアンシャーマ装置からのオゾン(O₃)による露光ラジカル成分(O*)が、図2の感光膜パターン24と化学的な反応のみを起こして、感光膜パターン24を除去する。

【0024】詳しく説明すれば、感光膜パターン24は、C-H-Oの基本構造からなり、その各々を連結する鎖は、露光ラジカル成分と化学的な反応を生じること

で、容易に切断される。

【0025】本発明は、既存のオゾンアンシャーマ装置からのオゾンを用いて露光ラジカル成分を生成し、この露光ラジカル成分を、感光膜パターンを微細化するに使用することとなる。すなわち、オゾンは、一定の温度に到達すれば容易に露光ラジカル成分に変わるため、エッチングチャンバー装置内に完全に密封した状態で、半導

体基板21上にオゾンを注入し、半導体基板21が装着されたヒーターブロック25に熱を加えれば、オゾンが露光ラジカル成分に変換される。この露光ラジカル成分が、感光膜パターン24に物理的な衝撃を加えないで、もたつた感光膜パターン24の連結鎖を切断する化学的な反応のみを起こして、感光膜パターン24を除去することとなる。

【0026】上記オゾンアンシャーマ装置を用いた感光膜パターン24を微細化する方法を具体的に説明する。まず、上記感光膜パターン24が形成された半導体基板21を、温度調節の可能なヒーターブロック25上に装着した後、ノズル（図示省略）を介してオゾン(O₃)ガスを供給する。この場合、上記オゾンは、酸素比5～7vol%の高濃度にする。

【0027】次に、上記ヒーターブロック25により上記半導体基板21を加熱すれば、上記供給されるオゾン(O₃)は熱分解されて、露光ラジカル成分(O*)が生成される。また、紫外線照射により、上記供給されるオゾン(O₃)から露光ラジカル成分(O*)が生成される。

【0028】このような露光ラジカル成分が感光膜パターン24を除去し、上記露光ラジカル成分の直進性により、感光膜パターン24の微細化が可能となる。

【0029】また、上記感光膜パターン24に含まれている炭素イオンや水素イオンは、露光ラジカル成分と反応して、感光膜パターン24の表面から、CO、CO₂又はH₂Oの状態で放出された後、オゾンアンシャーマ装置の外部に排出させることで、半導体基板21の微粒子による汚染を防止する。

【0030】図3は、アッシング時間に応じた感光膜パターンの大きさの変化を示した図である。オゾンアッシングを実施する前の感光膜パターン24の線幅は190nmに形成した場合に、オゾンアッシングを1分間実施すれば、感光膜パターン24の線幅は140nmに成る。感光膜パターン24の線幅は100nmに成ることを示している。このように、100nmの線幅を有する感光膜パターン24を形成したときにも、感光膜パターン24の崩れや大きさの変動は全く発生しなかった。

【0031】なお、上記感光膜パターン24は、ポジ

ティブ型感光膜又はネガティブ型感光膜のいずれかを用いて形成する。また、露光装置の光源として、g線(436nm)、i線(365nm)、ArF-エキシマレーザ(193nm)なども適用し得る。

【0032】本発明の技術的効果は、上記好ましい実施形態によって具体的に記述されたが、上記実施形態は本発明の目的の範囲内で種々の変形が可能であることとを理解されるべきである。

【0033】

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、大気圧下、かつ、低温で露光ラジカル成分を用いて、半導体基板上の感光膜パターンをアッシングすることにより、感光膜パターンのアッシング率を調節し得るので、微細な感光膜パターンの崩れや大きさの変動を防止して、通常の露光装置の限界解像力以上の0.1μm程度の微細な線幅を有する感光膜パターンを形成し得る。また、迅速に微細化された感光膜パターンを生成できるので、製品生成量を確保することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明にかかる半導体素子の感光膜パターンの形成方法の各工程を示す断面図である。

【図2】 本発明にかかる半導体素子の感光膜パターンの形成方法を用いた感光膜パターンの微細化を説明するための図である。

【図3】 本発明によりアッシング時間を変化させたときの感光膜パターンの線幅を示す図である。

【図4】 従来の技術にかかる半導体素子の感光膜パターンの形成方法の各工程を示す断面図である。

【図5】 従来の技術によって形成された感光膜パターンの崩れと大きさの変動を示す図である。

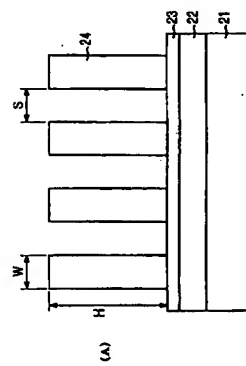
【符号の説明】

- 21 半導体基板
- 22 電導層
- 23 反射防止膜
- 24、24a 感光膜パターン
- 25 ヒーターブロック

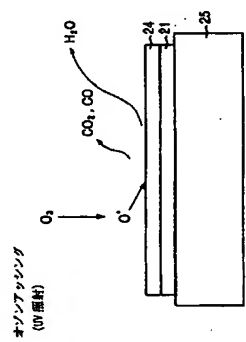
【図5】



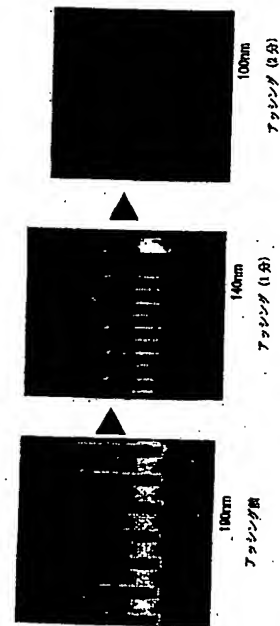
【图1】



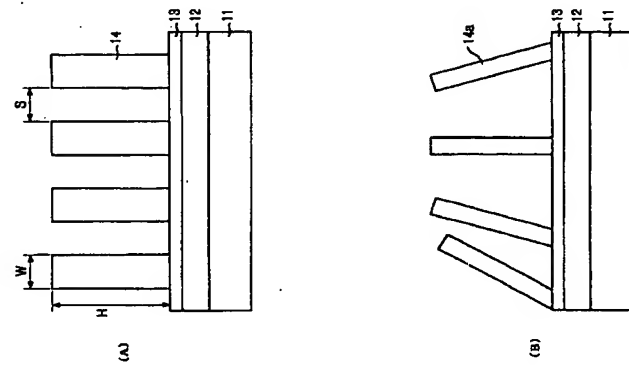
【图2】



【图3】



【图4】



フロントページの続き

Fターム(参考) 2H096 A400 A423 BA01 BA09 EA05
HA05 JA04
5F004 B001 DA27 DB26 EA01 EA12
5F046 MA12 MA18